

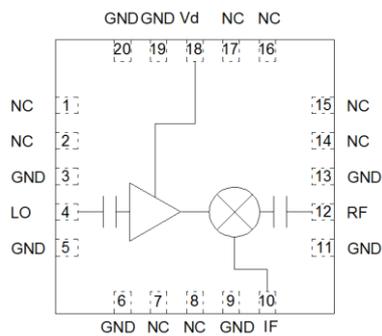
## 关键指标

- RF/LO 频段：3.5~9GHz
- IF 频段：DC~3GHz
- 变频损耗：-8dB IF=100MHz
- 本振功率：-4dBm
- 封装尺寸：5mm×5mm×1.2mm

## 典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 军事和航天
- 测试仪器
- 仪器仪表

## 功能框图



## 产品简介

XT3515Q5 是一款 GaAs MMIC 无源双平衡混频器变频芯片，封装于 5×5 的 QFN 壳体中，芯片射频频率覆盖 3.5~9GHz，本振频率覆盖 3.5~9GHz，中频频率覆盖 DC~3GHz，上下变频损耗小于 8dB，典型本振输入功率为 0dBm。

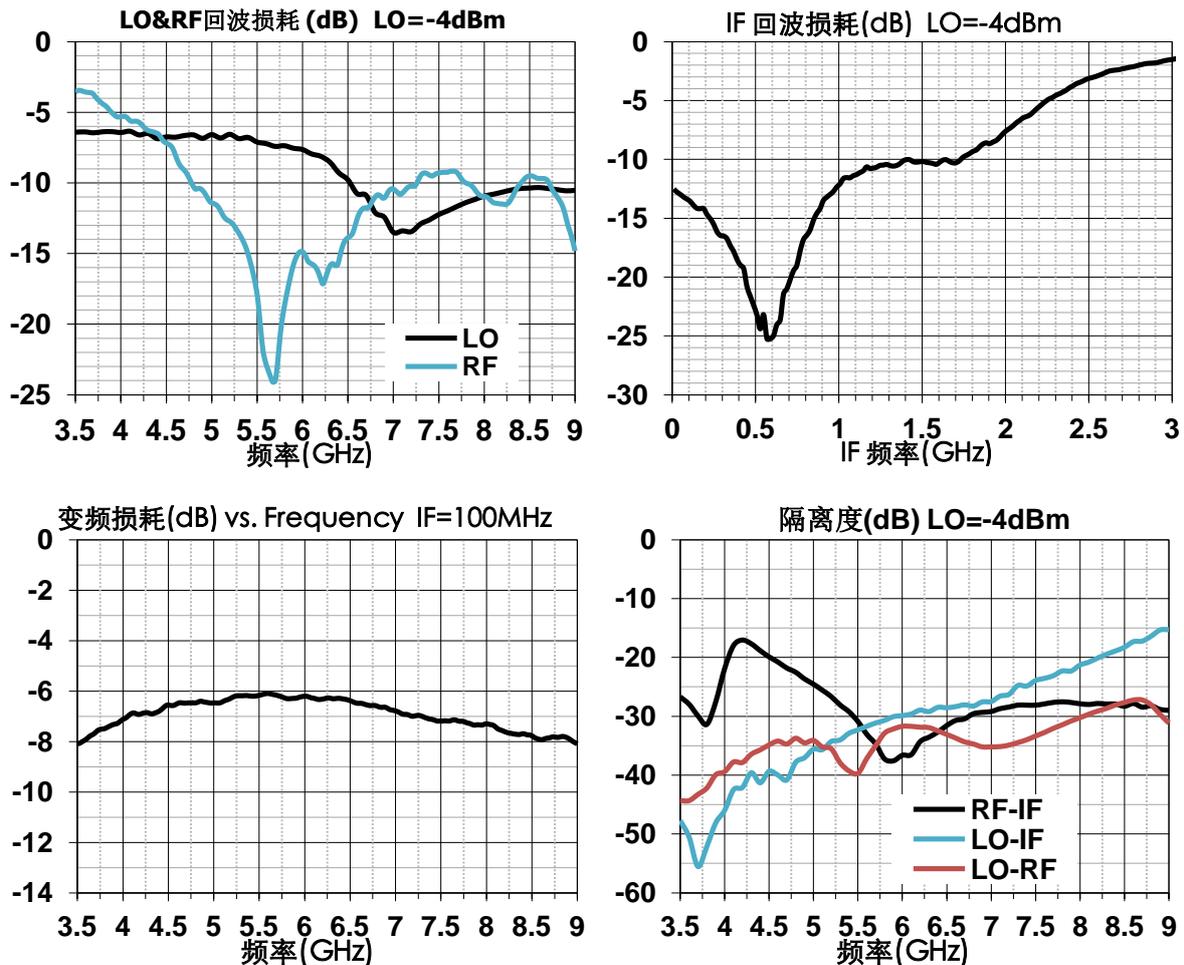
## 电性能 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , $LO=-4\text{dBm}$ , $V_D=+5\text{V}$ , $I_D=32\text{mA}$ )

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频/本振频率	3.5~9			GHz
中频频率	DC~3			GHz
变频损耗	—	-8	—	dB
IF 端回波损耗	—	-10	—	dB
RF 端回波损耗	—	-10	—	dB
LO 端回波损耗	—	-10	—	dB
本振-射频隔离度	—	-30	—	dB
本振-中频隔离度	—	-30	—	dB
射频-中频隔离度	—	-30	—	dB
输入 $IP_3$	—	18	—	dBm

## 绝对最大额定值

射频最大输入功率	20dBm	工作温度	-55°C~+85°C
本振最大输入功率	18dBm	存储温度	-65°C~+150°C
最大 $V_D$	+9V		

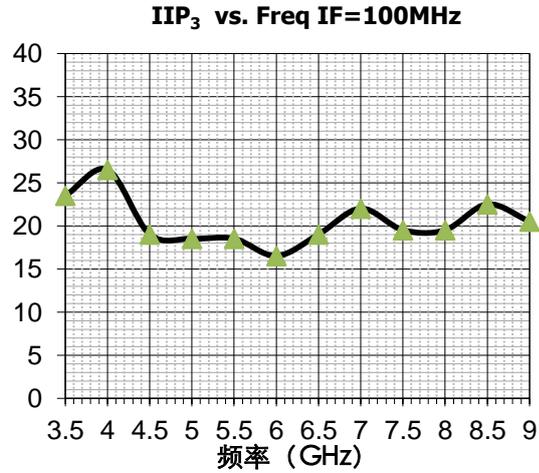
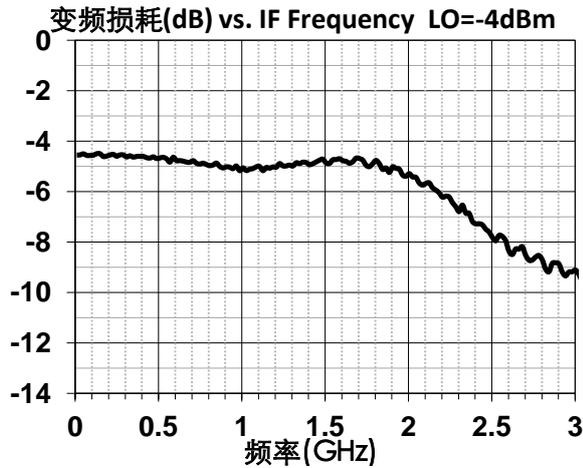
## 典型测试曲线



# XT3515Q5

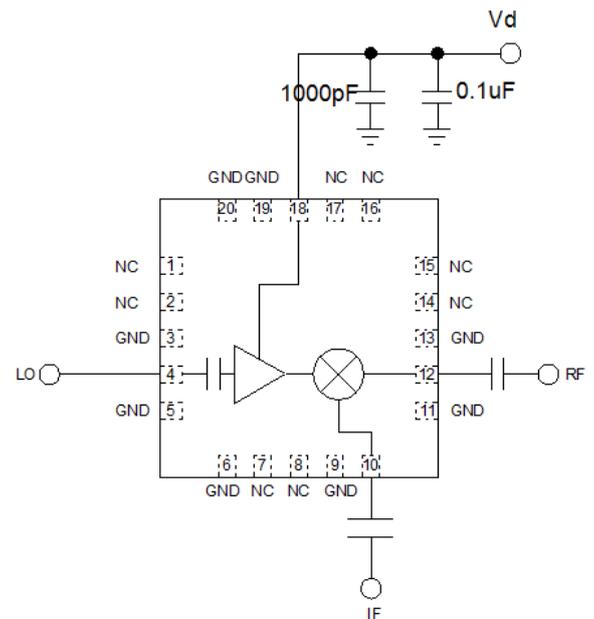
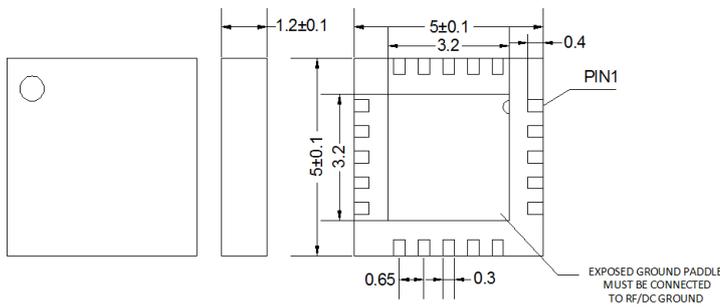
GaAs 单片集成无源双平衡混频器 (封装)  
3.5~9GHz

Rev 1.2



外形和端口尺寸 (mm)

推荐装配图



**注意事项:**

- 1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30° C/60% RH，四周车间寿命；
- 2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。